

| | |
|---|--|
|  | <h2 style="color: red;">SI1051X-T1-E3</h2> |
|  | Hersteller-Teilenummer: SI1051X-T1-E3 |
| | Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix |
| | Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 8V 1.2A SC89-6 |
| | Datenblätter:  SI1051X-T1-E3.pdf |
| | RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: New original, Stock Available. |
| | Liefern von: Hong Kong |
| Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SI1051X-T1-E3 |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET P-CH 8V 1.2A SC89-6 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 1V @ 250µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | SC-89-6 |
| Serie | TrenchFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 122 mOhm @ 1.2A, 4.5V |
| Verlustleistung (max) | 236mW (Ta) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | SOT-563, SOT-666 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 560pF @ 4V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 9.45nC @ 5V |
| Typ FET | P-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 8V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | - |

SI1051X-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI1051X-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI1051X-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI1051X-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>SI1054X-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 1.32A SC89-6</p> |  <p>SI1050X-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 8V 1.34A SOT563F</p> |  <p>SI1051X-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 8V 1.2A SC89-6</p> |  <p>SI1050X-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 8V 1.34A SC-89-6</p> |
|  <p>SI1054X-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 1.32A SC89-6</p> |  <p>SI1051X-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 1.2A SC89-6</p> |  <p>SI1050X-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 8V 1.34A SOT563F</p> |  <p>SI1050X-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 8V 1.34A SC-89-6</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|--|
| SI1051X-T1-E3 Vishay / Siliconix | SI1051X-T1-E3 Datenblatt | SI1051X-T1-E3-Datenblätter | SI1051X-T1-E3 PDF | Vishay / Siliconix SI1051X-T1-E3 |
| SI1051X-T1-E3 Electronic | SI1051X-T1-E3-Komponenten | SI1051X-T1-E3-Verteiler | SI1051X-T1-E3-Bild | SI1051X-T1-E3-Teil |
| SI1051X-T1-E3 Preis | SI1051X-T1-E3 Hersteller | SI1051X-T1-E3 Bild | SI1051X-T1-E3 Aktie | SI1051X-T1-E3 Inventar |
| SI1051X-T1-E3 Neu | SI1051X-T1-E3 Original | SI1051X-T1-E3 garantiert | SI1051X-T1-E3 RFQ | SI1051X-T1-E3 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited